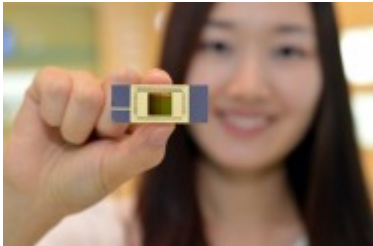


Comienza la producción en masa de memorias 3D de Samsung

Además de estar sumergida en [la producción](#) de su nueva memoria DRAM LPDDR3 de bajo consumo para dispositivos móviles con 4 gigabits de capacidad y tecnología de fabricación de 20 nanómetros, **Samsung** ha anunciado el inicio de las operaciones también para su memoria **V-NAND**.



Esto es, para **la primera memoria Flash NAND tridimensional con estructura vertical de la industria**, que promete sustanciales mejoras respecto a generaciones actuales y pasadas al utilizar la tecnología propietaria de la firma surcoreana basada en 3D CTF y un proceso de interconexión vertical para enlace de matrices.

¿Una de sus principales consecuencias? Poder entregar una densidad mínima de **128 gigabits en un solo chip**.

“La nueva tecnología V-NAND Flash 3D es el resultado del esfuerzo de nuestros empleados durante años para ir más allá del pensamiento convencional y adoptar enfoques más innovadores con los que superar las limitaciones en el diseño de la tecnología de semiconductores de memoria”, [dice](#) Jeong-Hyuk Choi, vicepresidente sénior de tecnología y productos Flash de Samsung Electronics.

“Después de la primera producción en serie del mundo de Vertical NAND 3D, vamos a seguir introduciendo productos V-NAND 3D con un mejor rendimiento y una mayor densidad, lo que contribuirá a un mayor crecimiento de la industria global de memoria”, ha añadido.

Esta memoria se construirá con proceso de 10 nanómetros y será utilizada para dar vida a múltiples productos de electrónica como **discos embebidos o unidades SSD de estado sólido**.

Más información en [The Inquirer](#).